

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年2月15日(2007.2.15)

【公開番号】特開2005-197456(P2005-197456A)

【公開日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【年通号数】公開・登録公報2005-028

【出願番号】特願2004-2142(P2004-2142)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 2 1 K 5/00 (2006.01)

G 2 1 K 5/02 (2006.01)

G 2 1 K 5/08 (2006.01)

H 0 5 H 1/24 (2006.01)

H 0 5 G 2/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 3 1 S

G 0 3 F 7/20 5 0 3

G 2 1 K 5/00 Z

G 2 1 K 5/02 X

G 2 1 K 5/08 X

H 0 5 H 1/24

H 0 1 L 21/30 5 3 1 A

H 0 1 L 21/30 5 1 7

H 0 5 G 1/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月18日(2006.12.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

半導体プロセスの微細化に伴って光リソグラフィも微細化が急速に進展しており、次世代においては、100～70nmの微細加工、更には50nm以下の微細加工が要求されるようになる。例えば、50nm以下の微細加工の要求に応えるべく、波長13nm程度のEUV光源と縮小投影反射光学系(catadioptric system)とを組み合わせた露光装置の開発が期待されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 8 】

